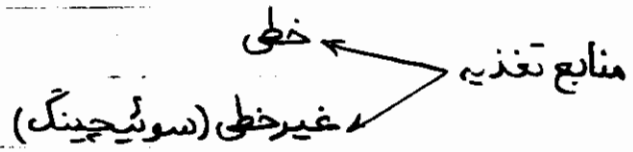


منابع تغذیه تثبیت شده :



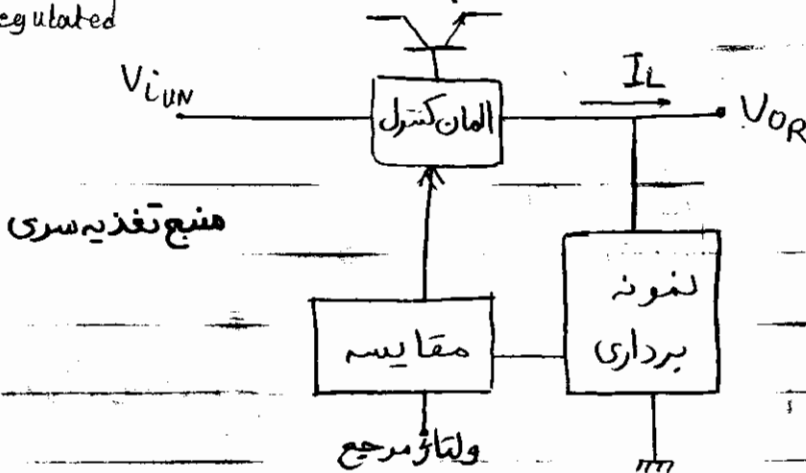
منبع تغذیه خطی =
وقتی می‌گوییم یک OP-Amp خطی کاری کند منظور این است که المان‌های داخلی آن

در ناحیه خطی کاری کنند و المان‌های بیرونی OP-Amp نیز المان‌های در ناحیه خطی

هستند.

UN = Unregulated
R = Regulated

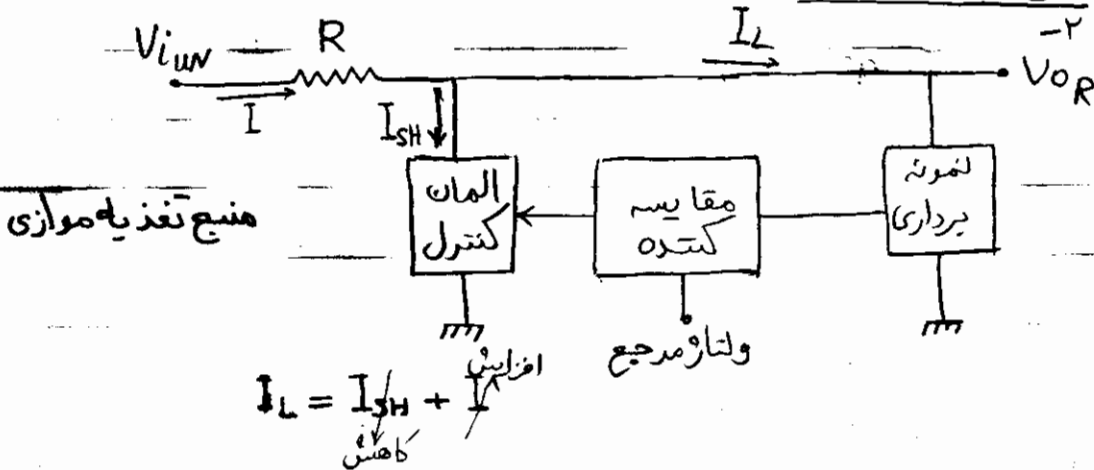
در منبع تغذیه غیرخطی المان‌های غیرخطی داریم (مانند دیود)



بسته به اینکه المان کنترل در شاخه سری باشد منبع تغذیه سری و اگر در شاخه موازی

-۱

باشد منبع تغذیه موازی خواهد بود.



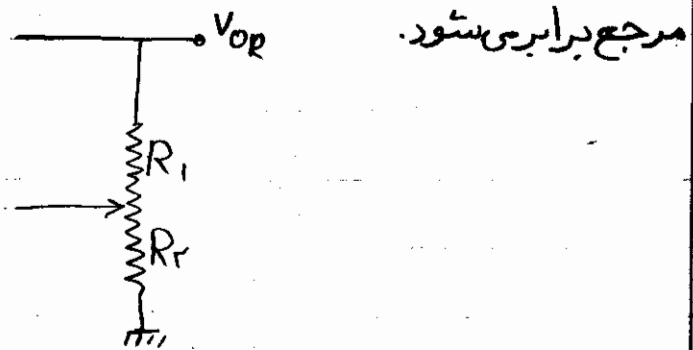
تذکره: معمولاً جریان شلخه نمونه برداری قابل مقایسه با جریان خروجی نیست.

یک رگولاتور سری خوب باید مصرف آن کم باشد و تفاوت ولتاژ ورودی و خروجی آن زیاد نباشد. در رگولاتور سری:

$$\text{تلفات ترانزیستور} = V_{CE} \cdot I_C = (V_i - V_o) I_L$$

در رگولاتور سری تلاش بر این است که ولتاژ نمونه برداری برابر ولتاژ مرجع شود

المان نمونه برداری یک پتانسیومتر است که با تنظیم آن ولتاژ نمونه برداری با ولتاژ



$$\frac{R_r}{R_1 + R_r} V_o = V_R \longrightarrow V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_r}\right) V_R$$

مرجع

معمولاً استفاده از رگولاتور سری وقتی مناسب است که Range ولتاژ دریافتی کم باشد

چون مثلاً در Range ۰ تا ۳۰ ولت که زیاد است چون V_i حدود ۳۰ است اگر V_o

کم بگیریم و جریان زیاد بکشیم تلفات ترانزیستور زیاد بوده و گرم می شود.

اگر بخواهیم جریان بالا داشته باشیم از رگولاتور موازی استفاده می کنیم:

به عنوان مثال اگر $I_L = 100$ و $I = 105$ باشد با تغییرات I_L ، دامنه تغییرات I_{SH}

حدود 10^A است و نتیجه جریان کمی از المان کنترل عبور کرده و تلفات کمی داریم در

صورتیکه اگر از رگولاتور سری استفاده کردیم تمام 105^A از المان کنترل می گذشت.

البته در رگولاتور موازی هم تلفات در خروجی خواهیم داشت یعنی در هر دو نوع رگولاتور

تلفات کلی برابر است، اما مهم این است که تلفات المان کنترل کم باشد.

در نتیجه کاربرد رگولاتور موازی موافق است که جریان خروجی بالایی می خواهیم، اما

دامنه تغییرات جریان خروجی کم است.

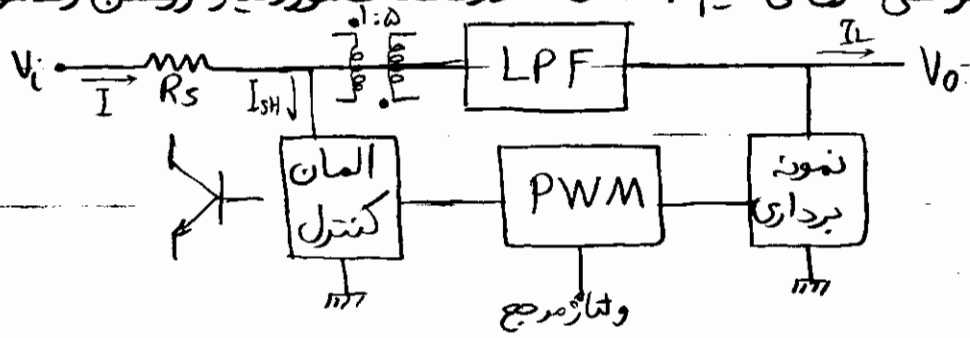
رگولاتور غیر خطی :

در رگولاتور خطی راندمان از رابطه $\eta = \frac{P_o}{P_i} = \frac{P_i - P_d}{P_i}$ بدست می آید که بسته

به انتخاب ولای تولد η را ماکزیم کرده اما در نهایت در این رگولاتور راندمان

بالایی نمی توانیم بگیریم چون تمام المان های مدار همواره روشن هستند. در

رگولاتور غیر خطی کاری می کنیم که المان ها در لحظات مورد نیاز روشن و خاموش شوند.



LPF = Low Pass Filter.

در این رگولاتور المان کنترل به صورت on, off کاری کند که فرمان روشن و

خاموش شدن آن توسط PWM صادر می شود. با انتخاب مناسب المان های

مداری توان تا ۹۰٪ راندمان گرفت. المان PWM با توجه به دامنه ولتاژ

نمونه برداری مقدار Duration جریان عبوری از المان کنترل را تعیین می کند

عمر از مزایای بالا بودن راندمان از مزیت های مهم رگولاتور غیر خطی این است که

می توان خروجی منفی گرفت. در رگولاتور خطی اگر می خواستیم خروجی منفی داشته

باشیم باید جریان در جهت عکس عبوری کرد که غیر ممکن بود (به علت عبور از ترانزیستور)

(فقط به عنوان ایده) (روش های دیگری هم وجود دارد)

اما در رگولاتور غیر خطی می توان با ایده قرار دادن یک ترانس قبل از LFC می توان

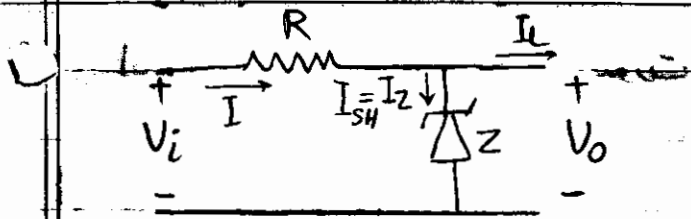
هم ولتاژ را منفی کرد هم می توان با دامنه مناسبی ولتاژ خروجی را زیاد کرد.

در رگولاتور خطی سه نوع ضریب تشبیه تعریف می شود.

$$S_V = \left. \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} \right|_{\substack{\Delta T=0 \\ \Delta I_L=0}} \quad , \quad S_I = \left. \frac{\Delta V_o}{\Delta I_L} \right|_{\substack{\Delta T=0 \\ \Delta V_i=0}}$$

مقاومت خروجی را نشان می دهد

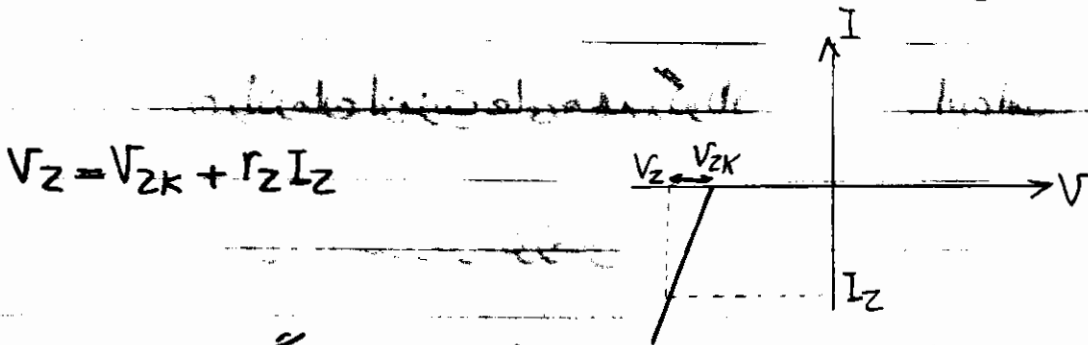
$$S_T = \left. \frac{\Delta V_o}{\Delta T} \right|_{\substack{\Delta I_L=0 \\ \Delta V_i=0}}$$



مثال ۳

اگر زنر ایده آل باشد هم چیز ایده آل بوده و \$V_Z\$ و \$I_Z\$ که ... صفر می شوند که نهایتاً

ما را به جایی نمی رساند. لذا از زنی با مشخصه زیر استفاده می کنیم:



در مشخصه با \$I_{Zmin}\$ برابر صفر است که گاهی اوقات اینگونه نخواهد بود و

$$I_{Zmin} = I_{ZK}$$

در مثال بالا: $V_o = V_i - RI = V_i - R(I_L + I_Z) \quad *$

$$V_o = V_Z = V_{ZK} + r_Z I_Z$$

اگر پارامترهای \$V_i\$, \$V_o\$, \$I_L\$, \$R\$, \$r_Z\$ و \$V_{ZK}\$ معلوم باشند:

با جایگزینی رابطه $\frac{V_o - V_{ZK}}{r_Z} = I_Z$ در رابطه * خواهیم داشت:

$$\rightarrow V_o = \frac{r_Z}{R + r_Z} V_i \text{ (۱)} - \frac{R \cdot r_Z}{r_Z + R} \frac{I_L}{\text{ (۲)}} + \frac{R}{R + r_Z} V_{ZK} \text{ (۳)}$$

رابطه بالا نشان می دهد که اگر \$V_i\$ زیاد شود، \$V_o\$ زیاد خواهد شد. اگر جریان خروجی زیاد

بکشیم، \$V_o\$ کاهش می یابد و تغییرات \$V_{ZK}\$ باعث تغییر \$V_o\$ خواهد شد.

$$\rightarrow S_V = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = \frac{r_z}{R+r_z} = \frac{10^{-1}}{1+10^{-1}} \approx 10^{-1}$$

$$S_I = \frac{\Delta V_o}{\Delta I_L} = \frac{-R \cdot r_z}{r_z + R} = -r_z \parallel R \approx 10^{-1}$$

$$S_T = \frac{\Delta V_o}{\Delta T} = \frac{R}{R+r_z} \cdot \frac{\Delta V_{zk}}{\Delta T} \approx \frac{\Delta V_{zk}}{\Delta T}$$

در کاتالوگ ذکر می شود
کلاس

$S_I = 10^{-1}$ بیان می کند که تغییرات ولتاژ با تغییرات امپدانس او را منتقل می شود.

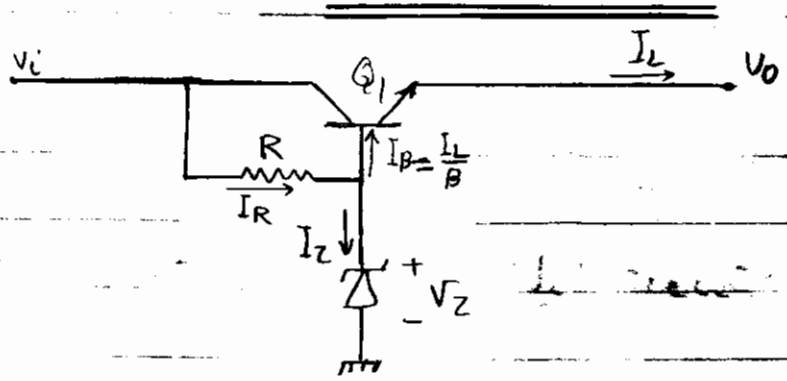
در این مدار می بینیم که مقادیر خوبی بدست نمی آید. دلیل این است که همه بلوک های

رگولاتور سری را زير انجام می دهد و در نتیجه ضریب ثبات خوبی نخواهیم داشت.

$$P_d = RI^2 + V_z I_z$$

نکته: چه در رگولاتور سری و چه در رگولاتور سنت المانی که در شاخه سری قرار می گیرد

تعیین کنند تلفات کلی مدار خواهد بود



در طرح بالا نمونه ای از ولتاژ V_o با V_z کمتر دوسر ز نظر ظاهر می شود:

$$V_z = V_{zk} + r_z I_z \quad , \quad V_o = V_z - V_{BE}$$

$$I_Z = I_R - I_B = I_R - \frac{I_L}{\beta} = \frac{V_i - (V_0 + V_{BE})}{R} + \frac{I_L}{\beta}$$

$$\rightarrow V_0 = \frac{r_Z}{R+r_Z} V_i + \frac{R}{r_Z+R} V_{ZK} - \frac{\frac{R \cdot r_Z}{\beta}}{R+r_Z} I_L - V_{BE}$$

$$\rightarrow S_V = \left. \frac{\Delta V_0}{\Delta V_i} \right| = \frac{r_Z}{R+r_Z} \approx \frac{r_Z}{R}$$

در حالت قبل هم که یک مقاومت وزیر داشتیم نیز همان رابطه بالا بدست آمده بود. اما

یک تفاوت وجود دارد. در حالت اول جریانی که از مقاومت می گذشت $I_L + I_Z$ بود ولی

در این حالت جریان کمتری برابر با $I_Z + \frac{I_L}{\beta}$ از مقاومت می گذرد. لذا مقاومتی در حد

کیلو اهم خواهیم داشت و در نتیجه S_V در حدود 10^{-4} خواهد بود:

$$S_V = \frac{r_Z}{R} = \frac{10^{-1}}{10^3} = 10^{-4}$$

$$S_I = \left. \frac{\Delta V_0}{\Delta I_L} \right| = - \frac{R \parallel r_Z}{\beta} \approx - \frac{r_Z}{\beta} \approx - \frac{10^{-1}}{10^2 \cdot 10} \approx -10^{-3} \text{ تا } -10^{-2}$$

$$S_T = \left. \frac{\Delta V_0}{\Delta T} \right|_{\substack{\Delta I_L = 0 \\ \Delta V_i = 0}} = \frac{R}{R+r_Z} \cdot \frac{\Delta V_{ZK}}{\Delta T} - \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} + \frac{(R \parallel r_Z) I_L}{\beta^2} \frac{\Delta \beta}{\Delta T}$$

در رابطه بالا چون تغییرات β با دما خیلی زیاد نیست و درترم آخر ضریب $\frac{1}{\beta^2}$ وجود

دارد نهایتاً با اعمال تقریب مناسب خواهیم داشت:

$$S_T \approx \frac{\Delta V_{ZK}}{\Delta T} - \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T}$$

اگر زنی با تغییرات حرارتی مثبت انتخاب کنیم، β مقدار کمی خواهد بود.

$$P_D = R I_R^2 + \frac{V_{CE} - I_C}{(V_i - V_o) I_L} + V_Z I_Z = R I_R^2 + \frac{(V_i - V_o) I_L}{w} + \frac{V_Z \cdot I_Z}{mw}$$

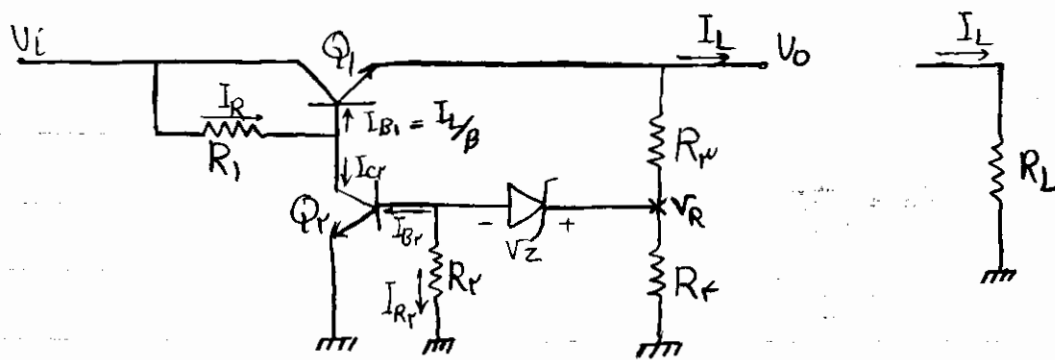
همانطور که گفته بودیم در رگولاتور سری المانی که در شافه سری قرار دارد بیشترین تلفات

را ایجاد می کند که در رابطه بالانیزی ببینیم.

در طرح بالا دیدیم که با اضافه کردن یک المان کنترل مجزا نسبت به رگولاتور قبلی ضریب

ثبات را با بهبودی مناسبی بدست آوردیم.

این بار واحد نمونه بردار مدار رانیز مجزا می کنیم و زنی دیگر نمونه بردار نخواهد بود:



در طرح بالا نیز هم نقش مقایسه کننده دارد و هم نقش ولتاژ مرجع را دارد. ولتاژ مرجع

همان V_Z خواهد بود که با ولتاژ دوسر R_3 مقایسه خواهد شد.

با فرض ثبات شدن ولتاژ V_o می توانیم فرض کنیم که I_{R1} ثابت است (البته تغییرات خیلی

کمی با تغییرات V_o خواهد داشت.) حال اگر V_o کم شود، V_{R3} کاهش خواهد یافت.

زیر با مقایسه کردن ولتاژها فرمان کاهش ولتاژ بیس Q_2 را می‌دهد. در نتیجه I_{C2} کم

می‌شود. چون I_R تقریباً ثابت است لذا I_{B1} و در نتیجه I_L زیاد شده و V_0 زیاد می‌شود.

وجود مقاومت R_F ، مسیری برای با یاس زتر خواهد بود. چون اگر R_F وجود نداشته باشد

با صفر شدن I_{C2} ، I_{B1} به سمت صفر رفته و دیود را خاموش می‌کند که مطلوب نیست.

با فرض صرف نظر کردن جریان زتر در مقابل جریان R_F و R_F خواهیم داشت:

$$V_R = \frac{R_F}{R_F + R_F} V_0 \rightarrow V_0 = \left(\frac{R_F}{R_F} + 1 \right) V_R$$

$$V_R = V_Z + V_{BE2}, \quad V_Z = V_{ZK} + r_Z I_Z$$

$$I_Z = I_{R2} + I_{B2} = \frac{V_{BE2}}{R_F} + \frac{I_{C2}}{\beta_2}$$

$$I_R = I_{C2} + \frac{I_L}{\beta_1} \rightarrow I_{C2} = I_R - \frac{I_L}{\beta_1}$$

$$I_R = \frac{V_i - (V_0 + V_{BE1})}{R_1}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow V_0 = & \frac{1}{1 + \frac{\beta_2 R_1}{r_Z} \cdot \frac{R_F}{R_F + R_F}} V_i - \frac{\frac{R_1}{\beta_1}}{1 + \frac{\beta_2 R_1}{r_Z} \cdot \frac{R_F}{R_F + R_F}} I_L \\ & + \frac{\beta_2 \frac{R_1}{r_Z}}{1 + \frac{\beta_2 R_1}{r_Z} \cdot \frac{R_F}{R_F + R_F}} V_{ZK} - \frac{\beta_2 \frac{R_1}{r_Z \parallel R_F}}{1 + \frac{\beta_2 R_1}{r_Z} \cdot \frac{R_F}{R_F + R_F}} V_{BE2} \\ & + \frac{V_{BE1}}{1 + \frac{\beta_2 R_1}{r_Z} \cdot \frac{R_F}{R_F + R_F}} \end{aligned}$$

$$S_V = \frac{\Delta V_O}{\Delta V_i} \bigg|_{\substack{\Delta T=0 \\ \Delta I_L=0}} = \frac{1}{1 + \frac{\beta_2 R_1}{r_2} \cdot \frac{R_F}{R_3 + R_4}} \approx \frac{1}{\frac{10^2 \times 10^3}{10^1}} = 10^{-6}$$

ترانزیستور Q_1 چون جریان آمپری از آن می‌گذرد باید β پایین داشته باشد اما Q_2

ترانزیستور با توان پایین خواهد بود چون جریان میلی آمپری از آن می‌گذرد و در نتیجه β

آن حدود ۱۰۰ خواهد بود.

با توجه به اعداد بالای بینیم که S_V بهبودی بهتری یافته است که به علت وجود β_2

یا همان Q_2 خواهد بود. به Q_2 همان فرمان می‌گوئیم.

$$S_I = \frac{\Delta V_O}{\Delta I_L} \bigg|_{\substack{\Delta T=0 \\ \Delta V_i=0}} = - \frac{R_1 / \beta_1}{\left(\right)} \approx \frac{10^1 \times 10^2}{10^6} \approx 10^{-5} \sim 10^{-4}$$

در نتیجه اینجانب تأثیر Q_2 را در بهبودی S_I کمی بینیم.

$$S_T = \frac{\Delta V_O}{\Delta T} \bigg|_{\substack{\Delta I_L=0 \\ \Delta V_i=0}} = \left(\frac{\beta_2 R_1 / r_2}{\left(\right)} \right) \cdot \frac{\Delta V_{ZK}}{\Delta T} - \left(\frac{\beta_2 R_1 / r_2 \parallel R_1}{\left(\right)} \right) \cdot \frac{\Delta V_{BE2}}{\Delta T} + \frac{1}{\left(\right)} \cdot \frac{\Delta V_{BE1}}{\Delta T}$$

با توجه به رابطه بالای بینیم که ضرایب صورت $\frac{\Delta V_{ZK}}{\Delta T}$ و $\frac{\Delta V_{BE2}}{\Delta T}$ تقریباً برابر بوده و

همدیگر را می‌توانند خنثی کنند. با توجه به اعداد خواهیم دید که تغییرات حرارتی Q_1

تقریباً بی‌تأثیر بوده و S_T توسط دو ترم اول تعیین می‌شود که با نزدیک کردن آنها

به یکدیگر می‌توان S_T را کاهش داد. در طرح بالا Q_1 گرمای بیشتری تولید خواهد

کرد ولی گرمای آن تأثیری در $\frac{\Delta V_{BE1}}{\Delta T}$ ندارد.

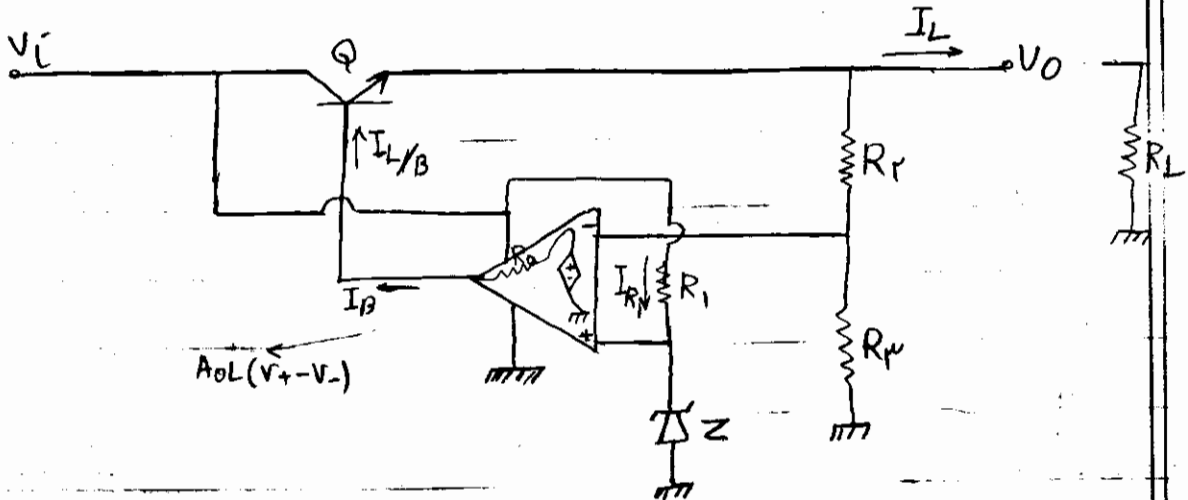
$$P_D = R_1 I_R^2 + R_2 I_R^2 + \frac{V_o^2}{(R_3 + R_4)} + V_Z I_Z + V_{CE2} I_{C2} + V_{CE1} I_{C1}$$

mW
mW
mW
mW
mW
mW
W

در طرح بالا دیدیم که با اضافه شدن یک المان کنترل اضافی نیز بهبودی بهتری در

ضرایب تثبیت بوجود می‌آید. حال طرح نهایی را ارائه می‌کنیم که در آن نمونه برداری با

گین بالا بکار رفته و است که یک Op-Amp خواهد بود:



چون افت ولتاژ V_{R3} باید معادل با افزایش I_B باشد با توجه به $A_{OL}(V_+ - V_-)$

می‌فهمیم که R_3 باید به ترمینال منفی Op-Amp متصل شود.

پارامترهای معلوم مدار عبارتند از: $A_{OL} - R_0 - V_{ZK} - V_Z - V_{BE} - \beta$

همانند موارد قبل برای نوشتن روابط از خروجی شروع می‌کنیم:

$$V_- = \frac{R_3}{R_2 + R_3} V_o, \quad V_+ = V_Z = V_{ZK} + I_Z R_2 \quad \textcircled{1}$$

$$I_2 = I_{R_1} = \frac{V_i - V_2}{R_1} \quad (2)$$

$$(1), (2) \rightarrow V_+ = V_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{2K} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_i$$

$$V_{O_{op-Amp}} = A_{OL}(V_+ - V_-) \approx -R_o \cdot \frac{I_L}{\beta}, \quad V_O = V_{O_{op-Amp}} - V_{BE}$$

$$\rightarrow V_O = \frac{R_2 + R_3}{R_2 + (1 + A_{OL})R_3} \times \frac{A_{OL} \cdot R_1}{R_1 + R_2} V_{2K} + \frac{R_2 + R_3}{R_2 + (1 + A_{OL})R_3} \times \frac{A_{OL} \cdot R_2}{R_1 + R_2} V_i$$

$$\approx - \frac{R_2 + R_3}{R_2 + (1 + A_{OL})R_3} V_{BE} - \frac{R_2 + R_3}{R_2 + (1 + A_{OL})R_3} \cdot \frac{R_o \cdot I_L}{\beta}$$

$$\rightarrow S_V = \left. \frac{\Delta V_O}{\Delta V_i} \right|_{\substack{\Delta T = 0 \\ \Delta I_L = 0}} = \frac{R_2 + R_3}{R_2 + (1 + A_{OL})R_3} \cdot \frac{A_{OL} \cdot R_2}{R_1 + R_2} \approx \frac{R_2 (R_2 + R_3)}{R_3 \cdot R_1}$$

برای تقسیم ولتاژ کردن مقادیر کیلواهی برای R_2 و R_3 مناسب است. برای بایاس کردن

$$\rightarrow S_V \approx \frac{R_2 (R_2 + R_3)}{R_3 \cdot R_1} \quad \text{زیر نیز مقدار کیلواهی برای } R_3 \text{ مطلوب است:}$$

انتظار داشتیم نسبت به حالت قبلی S_V بهتری داشته باشیم که می بینیم بهبودی چندانی

بدست نیآورده ایم. چون می خواستیم با افزایش گین نمونه برداری S_V که با بهبودی

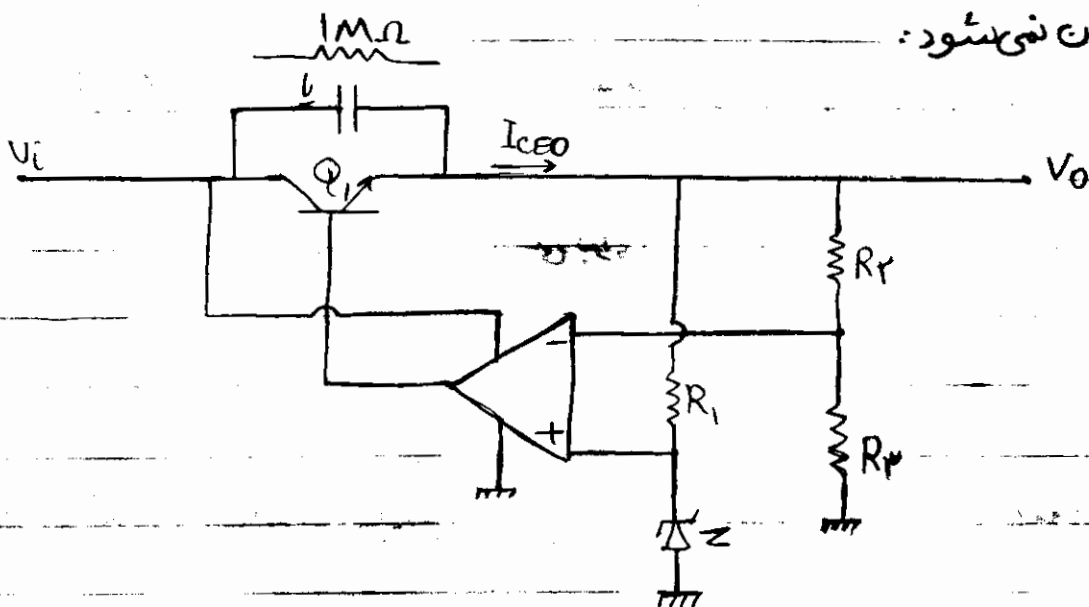
بهتری داشته باشیم. دلیل: حتی اگر گین نمونه برداری ∞ باشد، ایده آل این است که

نه تنها V_{R_3} و V_2 که باهم مقایسه می شوند باهم برابر شوند در این حالت V_0 مقداری

از V_2 خواهد بود که مثل همان مدار اولیه است.

برای حل این مشکل سر R_1 را به V_0 وصل می‌کنیم. اما در این حالت ایرادی وجود دارد که در لحظه اول زبر روشن نخواهد شد و نیاز به یک راه انداز دارد. لذا از یک مقاومت یا یک خازن برای راه اندازی زبر استفاده می‌کنیم. البته در عمل در سواردی که جریان بالا داریم، جریان I_{CEO} ترانزیستور کافی خواهد بود که زبر را راه اندازی کند و نیازی به مقاومت و خازن نخواهیم داشت. در لحظه اول چون V_0 صفر است

زبر روشن نمی‌شود:



در همان مدار قبل بقیه ضرایب تثبیت را بدست می‌آوریم:

$$S_I = \frac{\Delta V_0}{\Delta I_L} = - \frac{R_2 + R_3}{R_2 + (1 + A_{OL}) R_3} \cdot \frac{R}{\beta} \approx - \frac{10^3}{1.5 \times 10^3} \times \frac{10}{10^2} = -10^{-2}$$

در این مورد نیز اگر از ترانزیستور فرمان استفاده می‌کردیم بهبودی بهتری در S_I داشتیم.

$$S_T = \frac{\Delta V_0}{\Delta T} = \frac{R_2 + R_3}{R_2 + (1 + A_{OL}) R_3} \cdot \frac{A_{OL} \cdot R_1}{R_2 + R_1} \cdot \frac{\Delta V_{ZK}}{\Delta T} - \frac{R_2 + R_3}{R_2 + (1 + A_{OL}) R_3} \cdot \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T}$$

$$S_T = \frac{R_T + R_{T'}}{R_{T'}} \cdot \frac{\Delta V_{ZK}}{\Delta T} - \frac{R_T + R_{T'}}{A_{OL} R_{T'}} \cdot \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T}$$

خیلی بزرگ

در مقایسه با مدلی که یک زنر و یک ترانزیستور داشت در اینجا S_T بهبودی بهتری یافته است.

در مدار با یک زنر و ترانزیستور تأثیرات حرارتی زنر و ترانزیستور هر دو موثر بوده و در مقابل هم

قاربی گرفتند اما در اینجا با استفاده از Op-Amp، فقط تأثیرات حرارتی زنر موثر است

با محاسبه P_d خواهیم دید که در اینجا فیزیکاً بیشترین تلفات حرارتی را ترانزیستور یا

همان المان شاخصی دارد.

مدار فوق کاملترین تثبیت کننده ولتاژ است که تمام المان‌های یک رگولاتور ولتاژ

در آن به صورت مجزا بکار رفته است. اما محدودیت‌هایی را هم دارد. مانند محدودیت

$$I_{Omax\ op-Amp} \times \beta = I_L$$

$\beta_1 \beta_2$
↑
در لینگون

$$I_0 \times \omega_0 = 1A$$

جریان I_L که از رابطه مقابل

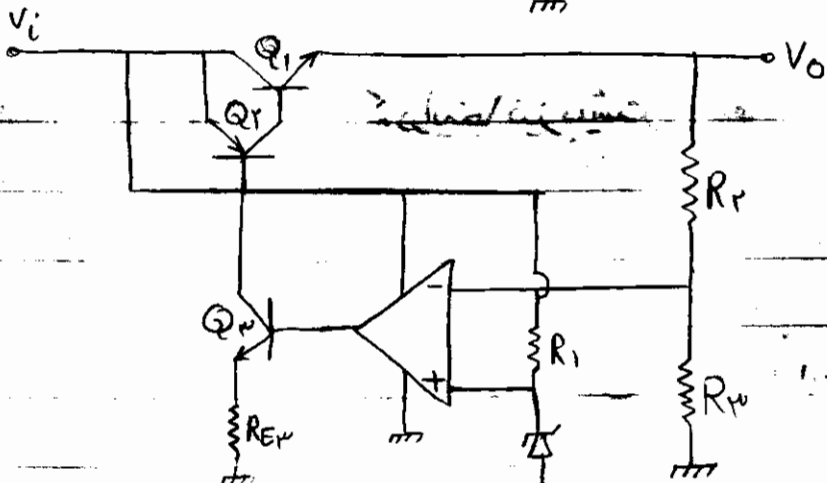
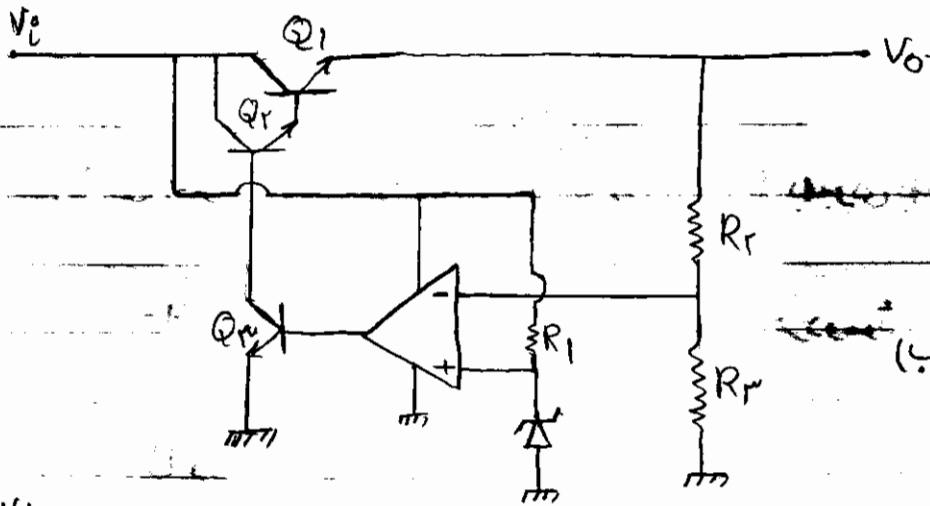
بدست می‌آید می‌توان برای بالا بردن I_L از ترکیب دارلینگتون استفاده کرد (به جای Q_1)

به هر حال با بالا بردن gain loop مقدار I_L افزایش می‌یابد. یکی از راه‌های افزایش

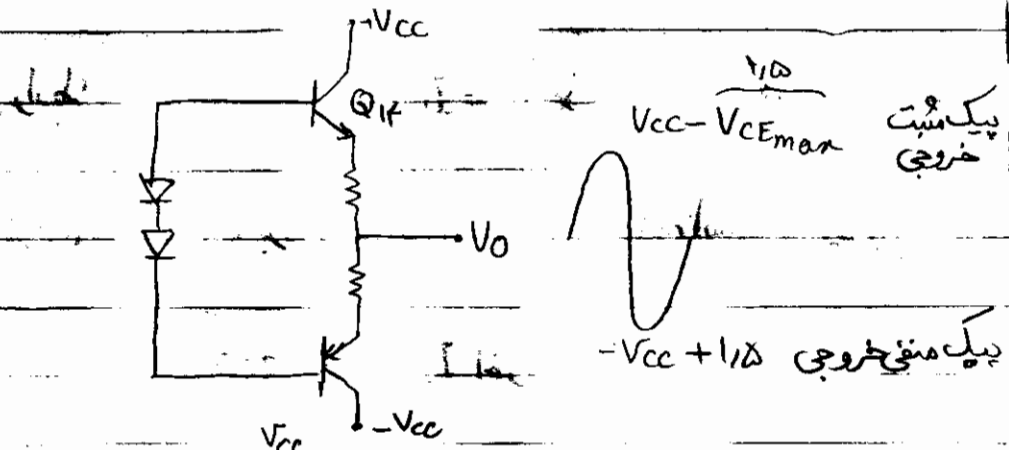
gain loop قرار دادن یک ترانزیستور (Q_3) در خروجی Op-Amp است. اما چون جریان

بیس Q_2 بالا و کلکتور Q_3 رویه پایین است لذا ترکیب دارلینگتون را به شکل دیگری

می‌بنویسیم:



اما مدار شکل (ب) اشتکالی در Q_3 دارد. با توجه به مدار داخلی Op-Amp :



لذا امپتر Q_3 تا V_{CEmax} و کلکتور آن تا $V_i - V_{CEmax}$ می تواند بالا می رود. در این حالت

اتفاقی که برای Q_1 می افتد این است که بیس آن جریان بسیار زیادی از کلکتورش

خواهد داشت و در ترانزیستوری که در آن رابطه $I_B \neq \frac{1}{\beta} I_C$ برقرار نباشد

V_{CE} آن صفر بوده و اشباع می شود. لذا به محض وصل کردن مدار Q_1 اشباع

می شود برای حل این مشکل جریان Q_3 را باید پائین بیاوریم به طوری که $\frac{1}{\beta}$ جریان

کلکتور Q_1 شود. لذا از یک مقاومت در امیتر Q_3 استفاده می کنیم، در این حالت

$$V_{O_{op-amp}} = R_{E3} (I_{C3}) + V_{BE}$$

\downarrow
 $I_L / \beta_1 \beta_2$

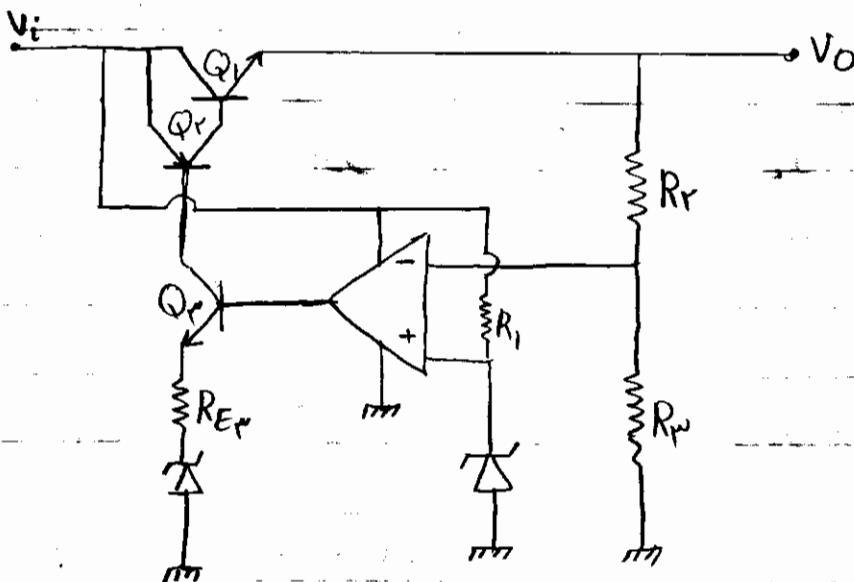
با انتخاب مناسب R_{E3} می توان خروجی $op-amp$ را در جایی تنظیم کنیم که بیشترین

سوئیچ را داشته باشد.

در مدار فوق Q_3 نقش یک تقویت کننده امیتر مشترک را بازی می کند البته می توان

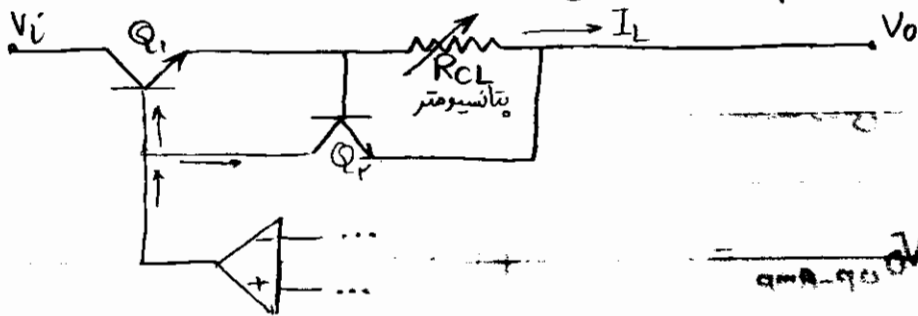
برای اینکه حساسیت Q_3 را بسیار بالا ببریم از یک ترانزیستور استفاده می کنیم که در این حالت

نیازی به R_{E3} زیاد نداریم.



می خواهیم در مدار فوق بتوانیم جریان خروجی I_L را کنترل کنیم. لذا باید یک

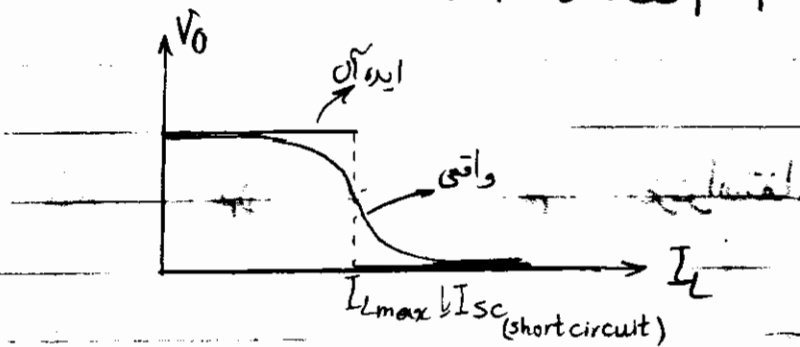
نمونه بردار استفاده کنیم که در شکل زیر نشان داده شده است:



در محدوده کننده جریان بالا تا زمانی که $I_L \cdot R_{CL} < V_{BE}$ است Q_2 خاموش است اما

وقتی که $R_{CL} = V_{BE_{on}} / I_{L_{max}}$ روشن شده و جریان را محدود می کند. مقاومت

R_{CL} باید یک مقاومت کم اهم ولی بتواند بالا باشد.



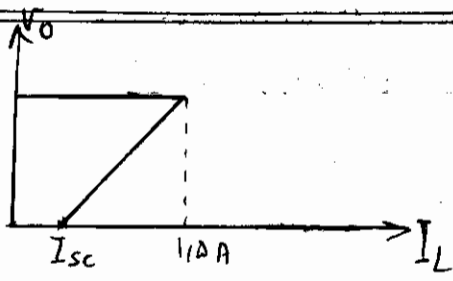
به مدار بالا، مدار محدود کننده جریان می گوئیم

به فرض مدار بالا را در 1.5^A تنظیم کنیم حال اگر I_L بیشتر از 1.5^A شود حتماً در

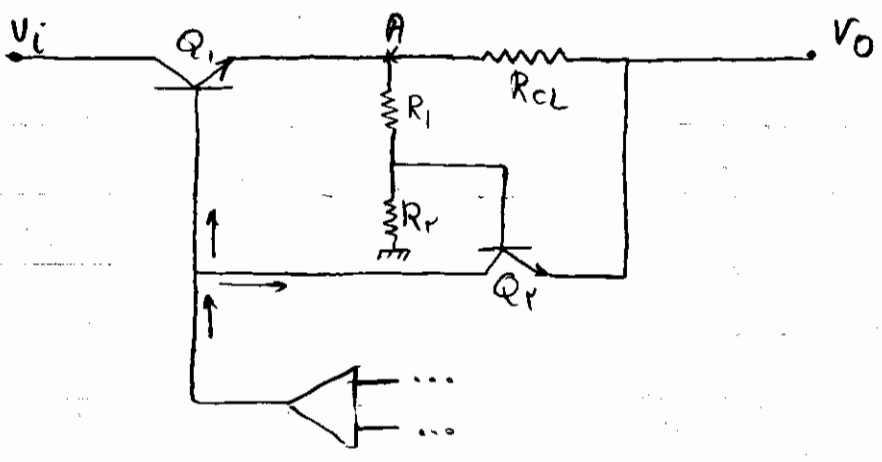
خروجی (در بار) مشکلی بوجود آمده است. حال می خواهیم در این حالت جریان به

جای اینکه ثابت بماند کم شود تا به بار آسیبی نرسد و از آن محافظت کرده باشیم

لذا مداری با مشخصه زیر می خواهیم:



به چنین مداری Fold back می‌گویند که در شکل زیر نشان داده شده است:



$$V_{BE2} = V_{BE0N}$$

$$V_{B2} - V_{E2} = V_A \cdot \frac{R_r}{R_1 + R_r} - V_o = (V_o + R_{CL} I_L) \frac{R_r}{R_1 + R_r} - V_o = V_{BE}$$

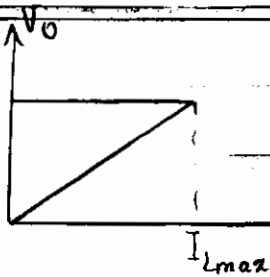
$$\rightarrow V_o \left(\frac{R_r}{R_1 + R_r} - 1 \right) + R_{CL} I_L \cdot \frac{R_r}{R_1 + R_r} = V_{BE2}$$

$$\rightarrow I_L = \frac{V_{BE} - V_o \left(\frac{R_r}{R_1 + R_r} - 1 \right)}{R_{CL} \cdot \frac{R_r}{R_1 + R_r}}$$

$$\rightarrow I_{L_{max}} = \frac{(R_1 + R_r) V_{BE0N} + \overset{1R_{CL}}{V_o} \cdot R_1}{R_{CL} \cdot R_r}$$

if $V_o = 0 \rightarrow I_L = I_{sc} < I_{L_{max}}$

نوع دیگری از محدودکننده‌ها وجود دارند که به مدار قطع کننده موسوم هستند

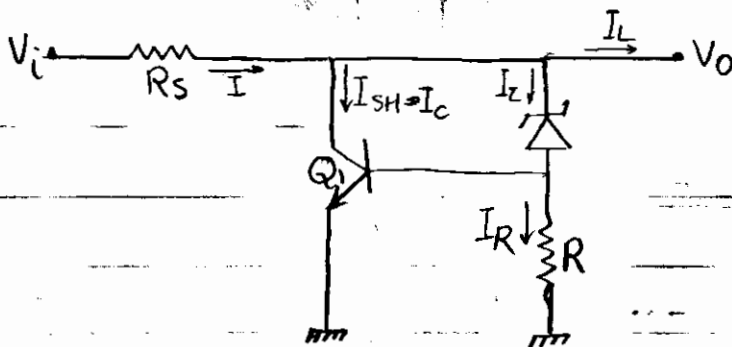


که مشخصه $V_o - I_L$ در آنها بصورت مقابل است:

برای ساخت چنین مداری نیاز به المان‌های غیرخطی I_L داریم.

خواهیم داشت که خواهیم دید باه ATJ می‌توانیم چنین مداری بسازیم.

رگولاتور شنت :



$$V_o = V_i - R_s I \quad , \quad I = I_L + I_Z + I_{SH}$$

$$V_Z = V_{ZK} + R_Z I_Z = V_o - V_{BE} \quad \rightarrow \quad I_Z = \frac{V_o - V_{BE} - V_{ZK}}{R_Z}$$

$$I_B = I_Z - I_R = I_Z - \frac{V_{BE}}{R} \quad , \quad I_{SH} = \beta I_B$$

بعد از جایگزینی

$$V_o = \frac{r_z}{r_z + \beta R_s} V_i - \frac{R_s r_z}{r_z + \beta R_s} I_L + \frac{\beta R_s}{r_z + \beta R_s} (V_{ZK} + V_{BE})$$

$$\rightarrow S_V = \left. \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} \right| = \frac{r_z}{r_z + \beta R_s} \approx \frac{r_z}{\beta R_s}$$

$$S_I = \left. \frac{\Delta V_o}{\Delta I_L} \right| = - \frac{R_s r_z}{r_z + \beta R_s} \approx - \frac{r_z}{\beta}$$

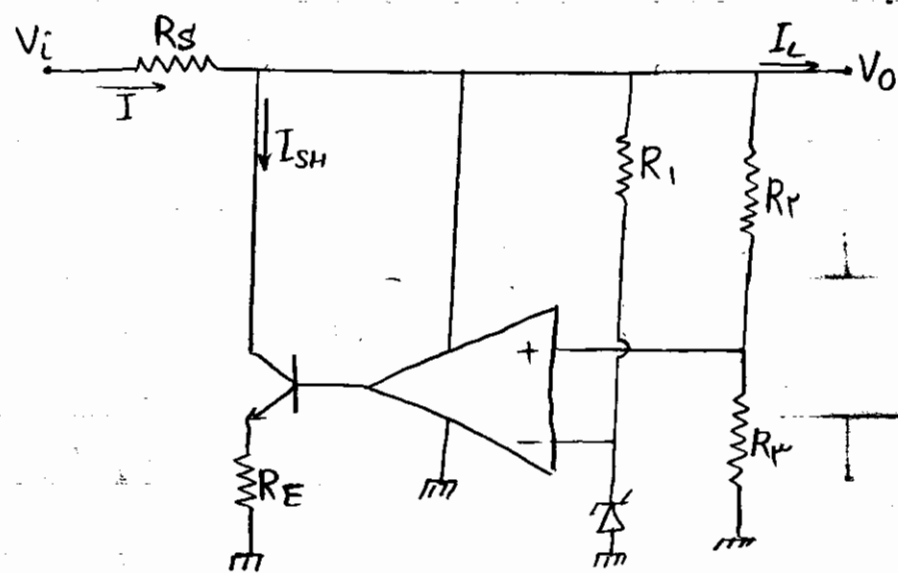
$$S_T = \left. \frac{\Delta V_o}{\Delta T} \right| = \frac{\beta \cdot R_s}{r_z + \beta \cdot R_s} \left(\frac{\Delta V_{ZK}}{\Delta T} + \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} \right)$$

که ضرایب ثبیت بالا در مقایسه با اولین مدار که شامل زنر و مقاومت بود بهبودی

یافته اند. البته در این مدار فقط المان کنترل به صورت مجزا بکار رفته است. اگر

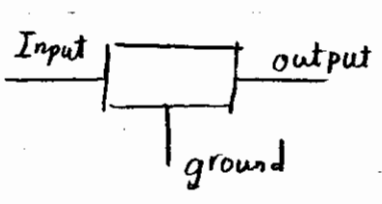
تمام المان های یک رگولاتور را به طور مجزایه کار ببریم بالطبع، کاملترین رگولاتور است

را خواهیم داشت:



تمرین: ضرایب S_V , S_I و S_T را برای مدار بالا بدست آورید.

رگولاتورهای ذکر شده عموماً به صورت مدارهای مجتمع ساخته می شوند که دارای

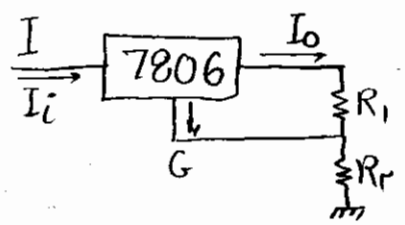


سه پایه هستند:

چنین IC هایی با نام LM78XX هستند که XX نشان دهنده ولتاژ خروجی

خواهد بود که مقادیر استاندارد آن ۰۵، ۰۶، ۰۸، ۰۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۴

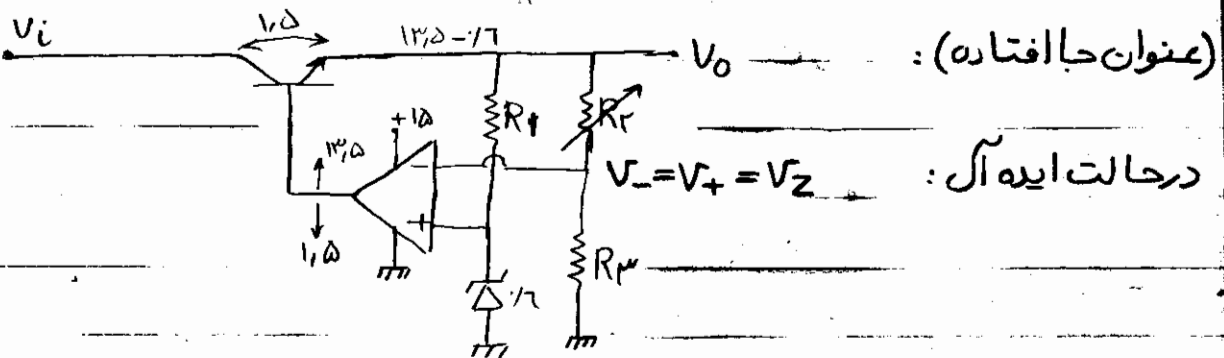
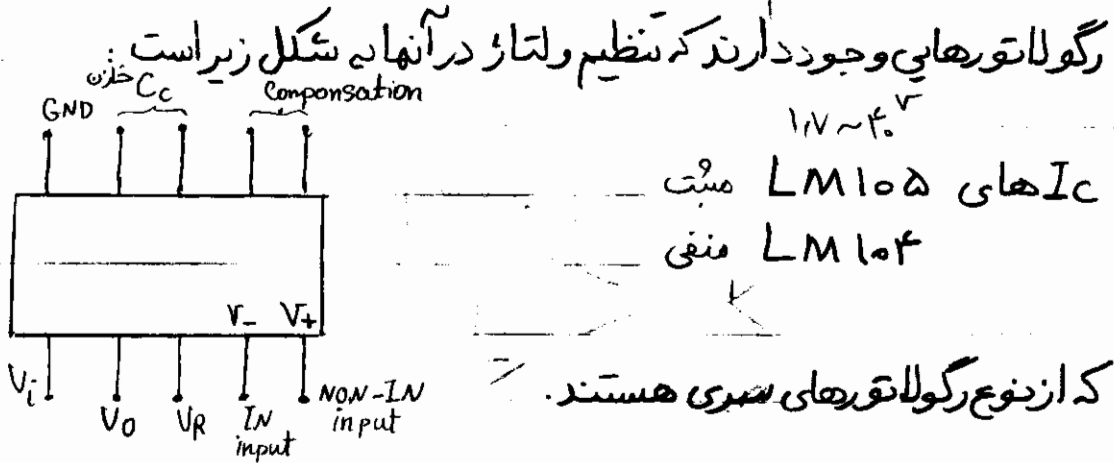
است. عدد ۷۸ نشان دهنده رگولاتور مثبت است یعنی ورودی مثبت، خروجی مثبت



نوع دیگر رگولاتورها، IC های بانام LM79 هستند که به عنوان رگولاتورهای

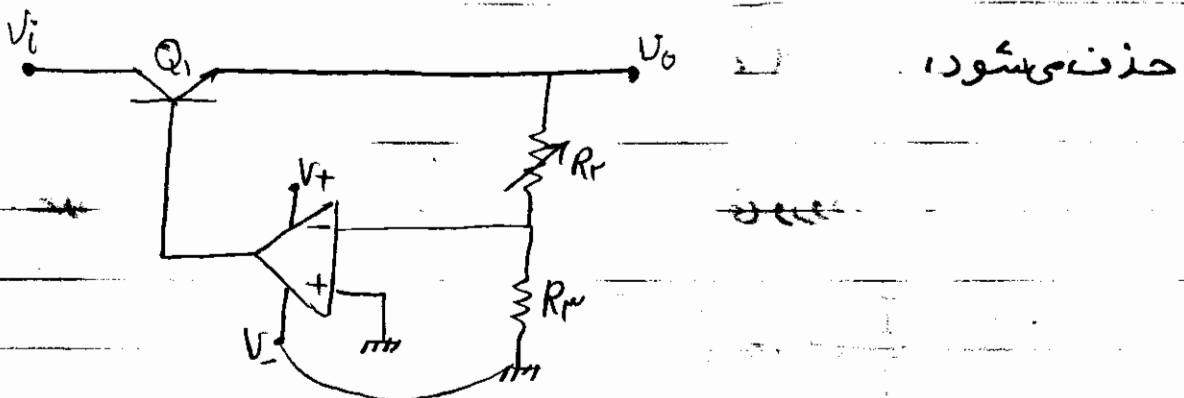
منفی به کار می روند. یعنی ورودی منفی، خروجی منفی.

مداری که در صفحه قبل دیده می شود برای تنظیم خروجی به کاری روژد



$$V_z = V_- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_o \rightarrow V_o = V_z \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

برای اینکه V_o صفر نشود، R_2 را صفر می کنیم و زئیر را بفرستیم که در این صورت R_1 نیز



در این صورت ناچاراً باید تغذیه منفی نیز داشته باشیم. چون Op-Amp ایده آل

است و $V_+ = V_-$ و برابر صفر هستند با توجه به اینکه V_0 مقدار دارد جریانی از R_2 بوبه پاسن سر از زیری شود برای اینکه این جریان وارد Op-Amp نشود و آن را به حالت غیر خطی نبرد باید R_3 را به V_- وصل کنیم. تا جریانی به R_3 وارد شود

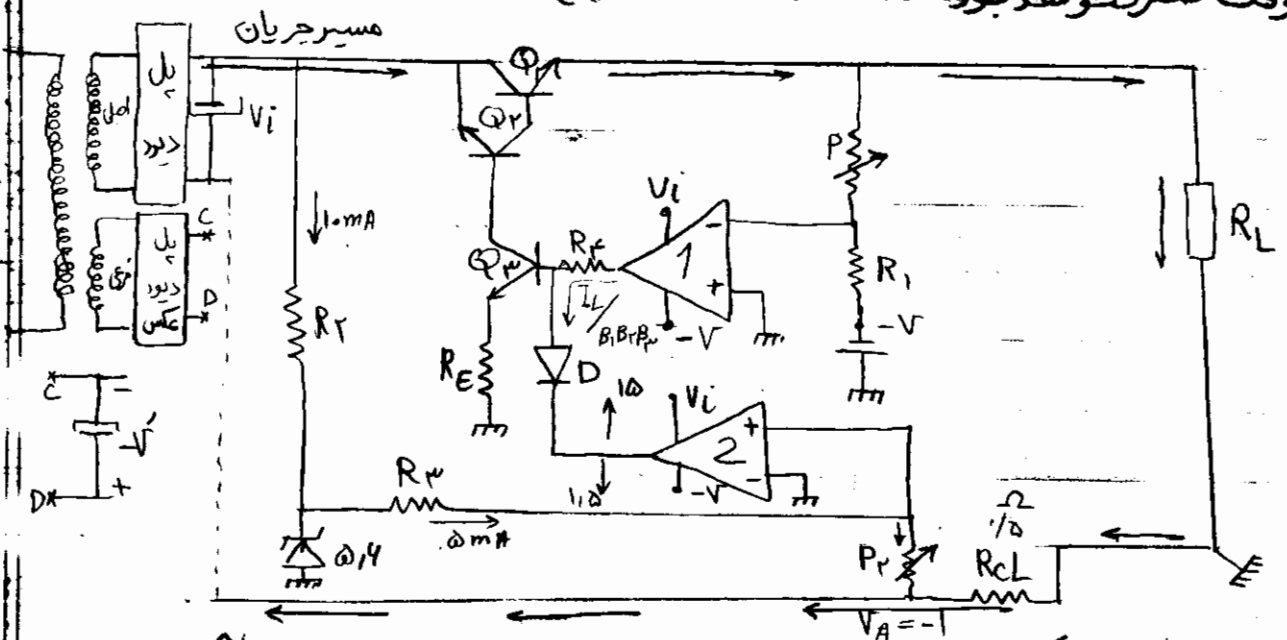
در این حالت: $I_{R_2} = I_{R_3}$

$$\frac{V_0}{R_2} = \frac{V}{R_3} \rightarrow V_0 = V \cdot \frac{R_2}{R_3}$$

لذا برای اینکه در خروجی ولتاژ صفر داشته باشیم باید تغذیه منفی داشته باشیم. در

نتیجه در خروجی I_C های LM105 و LM104 مقدار خروجی می بینیم هیچ

وقت صفر نخواهد بود.



در شکل بالا محدودکننده جریانی رای بینیم که قابل تنظیم بوده و جریان مدار وارد آن نمی شود.

مقاومت R_{CL} نمونه برداری جریان می‌کند. چون سرسخت چپ R_{CL} منفی است و باید وارد

ترمینال منفی Op-Amp شده و با ترمینال مثبت مقایسه شود لذا طراحی باید به گونه‌ای باشد که

وقتی I_L از مقدار ماکزیمم بیشتر شود V_+ هم از V_0 بیشتر شود. (V_0 اهم که صفر است).

پس باید در I_{Lmax} ولتاژ را به صفر برسانیم. برای این کار از یک پتانسیومتر P_p و دیود زبر

V_+

استفاده کنیم.

وقتی که I_L از I_{Lmax} کمتر است Op-Amp 2 به اشباع مثبت می‌رود و دیود D هم خاموش خواهد

بود و جریان مسیر خود را طی می‌کند. زمانی که I_L کمی از I_{Lmax} بیشتر شود V_+ از صفر به

طرف منفی رفته و Op-Amp به اشباع منفی می‌رود. در نتیجه دیود D روشن می‌شود و جریانی

از Op-Amp 1 به Op-Amp 2 سر از بیرون می‌شود. جریان I_m در این حالت مینیمم می‌شود

ولی صفر نخواهد شد چون در این صورت جریان ششانه اصلی مدار صفر خواهد شد. وجود

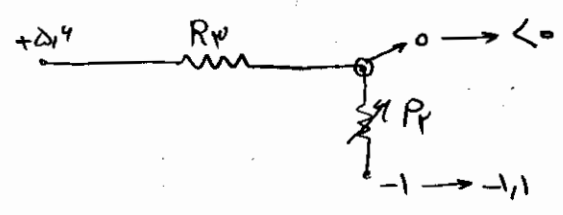
مقاومت R_F بین دو Op-Amp برای این است که اگر از Op-Amp 1 بیش از حد جریان بکشیم ولتاژ

آن افت پیدا نکند. جریانی که از P_p می‌گذرد در حد میلی آمپر است.

نکته: زمینی که مدار دارد باز مینی که V_0 دارد متفاوت است.

V_A را نسبت به صفر مدار ۱- ولت انتخاب کردیم که در این حالت V_+ صفر است. حال اگر I_L

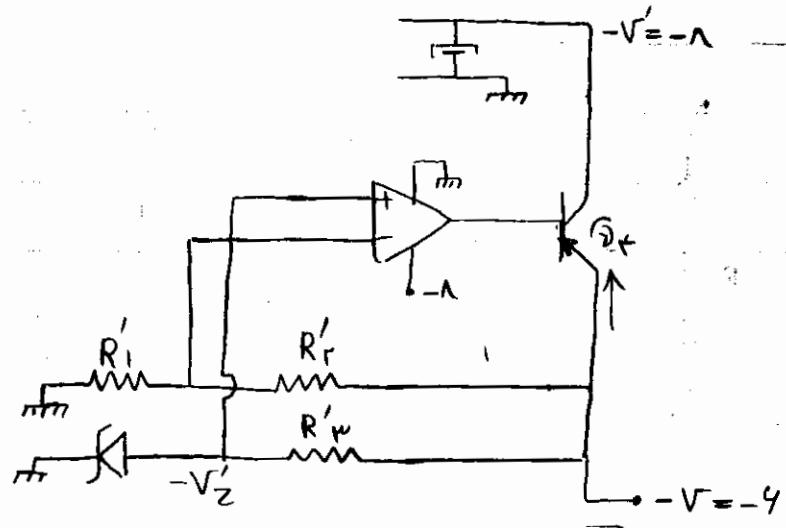
از I_{max} بیشتر شود V_A مثلاً V_A - شده و V_+ کوچکتر از صفر می شود.



برای اینکه ولتاژ V_- (تغذیه منفی و ولتاژ مرجع) را تولید کنیم از قسمت پل دیود فرعی استفاده

می کنیم که V_- تولید می کند. V_- کمی بیشتر از V_+ است. مثلاً اگر V_+ برابر ۶- باشد آن

گاه V_- برابر ۸- است. V_- را مطابق شکل زیر به یک رگولاتور دیگری دهیم تا $V_- = ۴-$ را بگیریم:



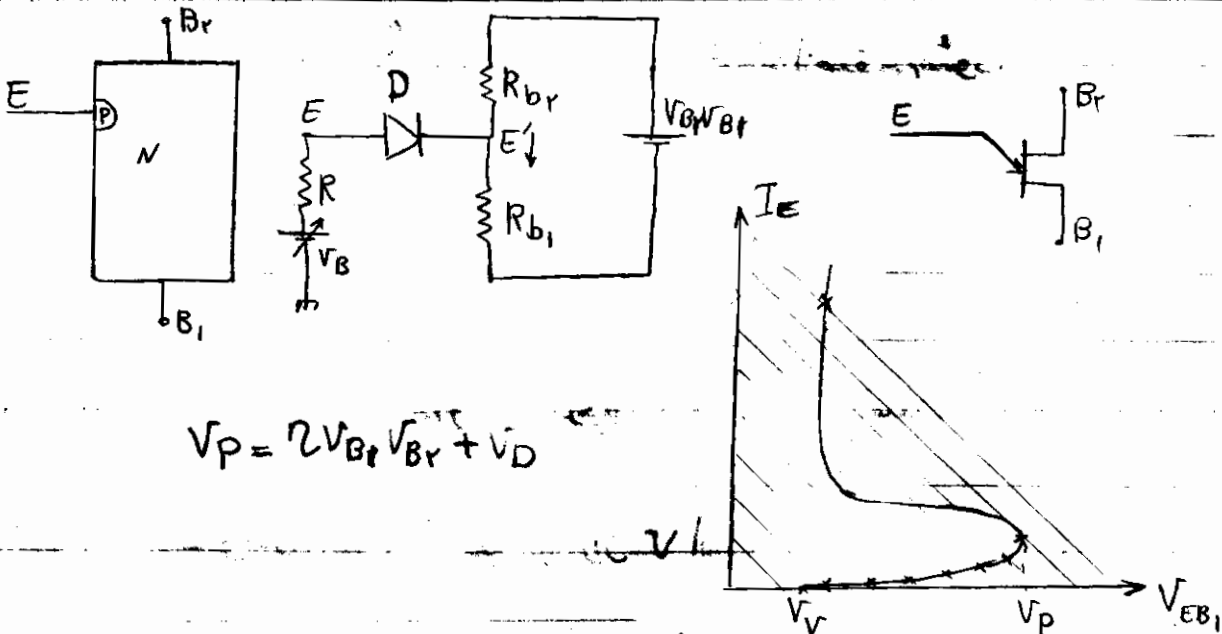
لذا باطری مدار را برداشته و آن را به V_+ بالا وصل می کنیم.

مقاومت های R_2 و R_3 در مدار اصلی برای بایاس کردن دیود زنر مدار اصلی است.

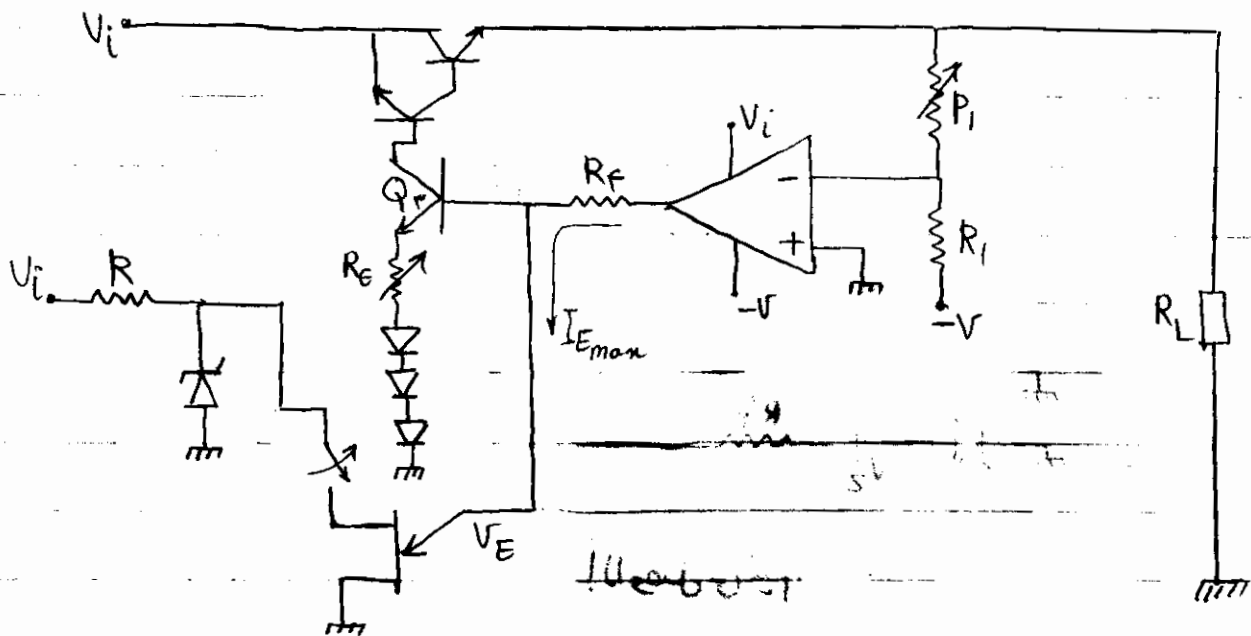
قطع کننده جریان:

(ان شاء...) که UJT را خاموش نکرده اید.

یادآوری UJT از الکترونیک I:



قطع کننده جریان : باز هم فرمان قطع کنندگی را در خروجی Op-Amp قرار می دهیم.



فرض می کنیم وقتی جریان I_{max} باشد باید قطع شود. با توجه به شکل ولتاژ روشن شدن آن

رابطه است می آوریم:

$$V_{BR} = R_E I_{E_{max}} + V_{BE}$$

$$\rightarrow \begin{cases} V_{BR} = R_E \frac{I_{L_{max}}}{\beta_1 \beta_2} + V_{BE} \\ V_p = 2V_i + V_D \end{cases}$$

بعد از روشن شدن $\mu A T$ می خواهیم جریان مدار صفر شود. (برخلاف محدود کننده جریان)

لذا جریان I_E باید صفر شود. برای این کار از سه دیود در امیتر Q_3 استفاده می کنیم.

حال جریان صفر شد مقدار R_E را انتخاب می کنیم. به این ترتیب که جریان R_E باید از

$$I_{E_{max}} \text{ المان } \mu A T \text{ تجاوز نکند تا } \mu A T \text{ نسوزد.}$$

چون دیودها را در امیتر Q_3 قرار دادیم لذا ولتاژ روشن شدن $\mu A T$ به صورت زیر

$$V_{B_3} = R_E \cdot I_{E_3} + V_{BE_3} + 3V_D \quad \text{تغییری کند:}$$

وقتی که جریان $I_{L_{max}}$ بیشتری شود $-V$ از $+V$ بیشتر شده و $OP-Amp$ = اشباع مثبت

می رود و $\mu A T$ روشن خواهد ماند. حال بار را از خروجی برداشتیم و می خواهیم دوباره

مدار کار کند. در این حالت باز هم $OP-Amp$ در اشباع مثبت خواهد ماند. (بالینکه I_L

صفر است). برای اینکه مدار کار کند باید I_L به نحوی خاموش شود که راه های

متفاوتی برای خاموش کردن آن وجود دارد:

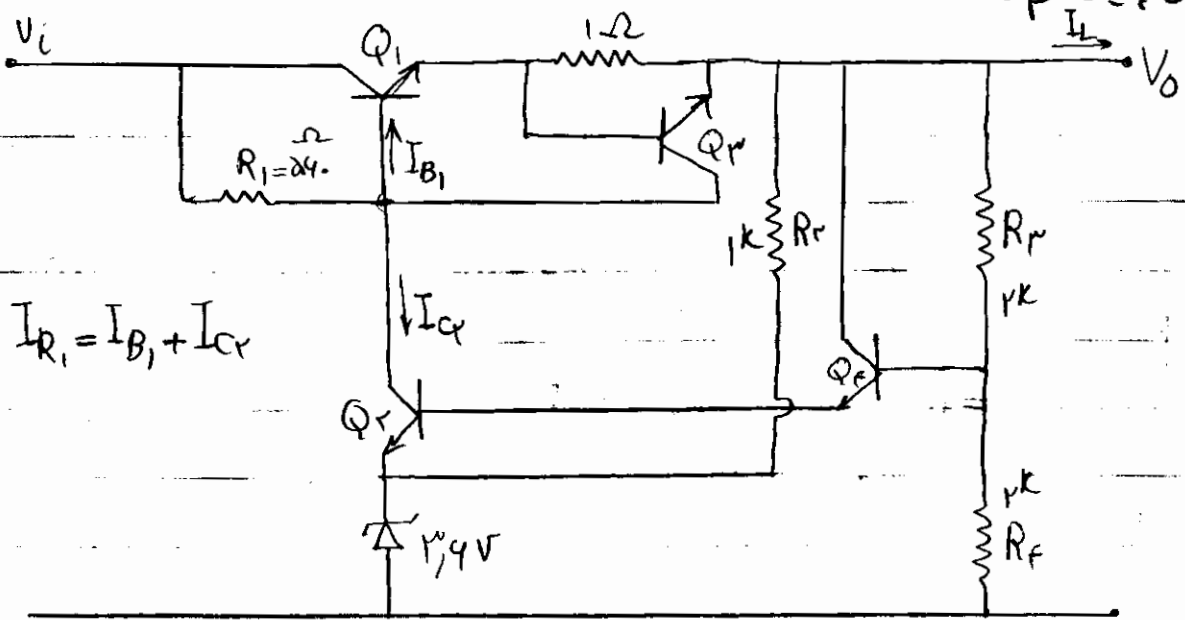
یک راه این است که یک کلید در امیتر $\mu A T$ قرار دهیم و آن را باز کنیم که این راه

مرسوم نیست. راه دیگر این است که I_L را قطع کنیم.

برای تنظیم کردن مقدر $I_{L_{max}}$ (مثلاً به جای 2^A ، 3^A) باید R_E را تغییر دهیم و برای اینکه $\mu A T$

هم در I_A جدید مثلاً 3^A قطع کنند از ترکیب زنر و مقاومت استفاده می کنیم.
 برای تولید V_i و V_o - هم همانند محدود کننده جریان از ترانس و... استفاده می کنیم.

سوال پایان ترم :-



$I_{R_1} = I_{B_1} + I_{C_2}$

الف لحز کار مدار مرجع - ولتاژ V_o - ج - جریان خروجی ماکزیم I_{Lmax}

$\beta = h_{fe} = 100$, $V_{BE} = 1V$, $V_{CEsat} = 1V$ I_{Lmax} V_{imin}

وقتی می گوئیم طرز کار مدار را توضیح دهید یعنی عاملی ولتاژ را از تثبیت خارج کند حال توضیح می دهید که مدار چگونه ولتاژ را تثبیت می کند. R_C و R_E نمونه بردار و ولتاژ مرجع زنر و Q_2 و Q_3 مقایسه کننده هستند. برای بایاس زنر است. چون وقتی I_{C_2} صفر می شود برای اینکه زنر روشن بماند از بایاس R_C استفاده می کنیم. وقتی V_o کاهش می یابد، V_{BE_3} کاهش می یابد و در نتیجه I_{B_3} کاهش خواهد یافت. کاهش I_{B_3} باعث کاهش

I_{C1} می شود. با فرض ثابت بودن I_{R1} در نتیجه I_{B1} افزایش می یابد و نهایتاً I_L

$$V_{BE1} = V_0 \cdot \frac{R_f}{R_{\pi} + R_E} \rightarrow V_0 = 1.7$$

افزایش و V_0 زیاد می شود.

جریان خروجی ماکزیمم وقتی است که I_{C1} صفر شود. اگر V_i را داده بود باید I_{R1} را محاسبه

و I_{B1} را بدست می آوریم. در اینجا محدود کننده جریان وجود دارد (Q_3) و لذا ماکزیمم

جریان خروجی را Q_3 تعیین می کند. لگرنه فرض V_{BE3} برابر 0.7 باشد:

$$V_{BE3} = I_{Lmax} \times 1^2 \rightarrow I_{Lmax} = 1.7 \text{ A}$$

$$V_{E1} = V_0 + 0.7 = 1.07$$

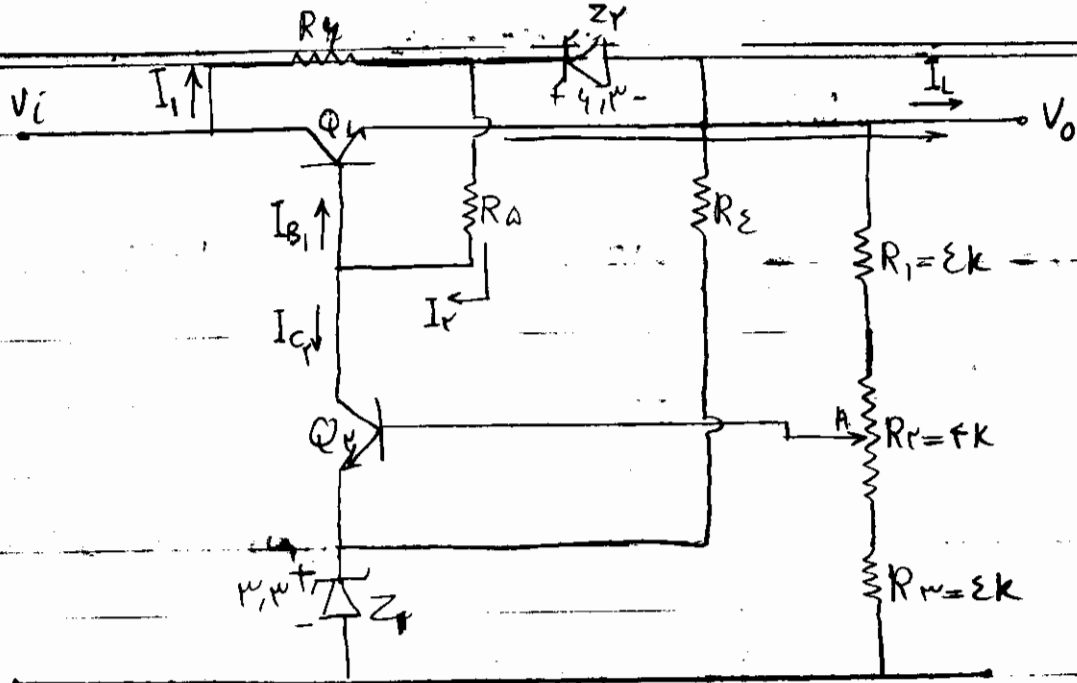
برای اینکه Q_3 وارد اشباع نشود پس V_i باید حداقل $1.07 + 0.3$ باشد.

$$V_i = R_1 I_{R1} + V_{BE1} + 1.07$$

وقتی که I_{Lmax} از مداری گذرد با فرض اینکه Q_3 عمل کرده و I_{C1} صفر شده:

$$V_{i_{min}} = R_1 \cdot \frac{I_{Lmax}}{\beta_1} + V_{BE1} + 1.07 = 15.32 \text{ V} \quad (2)$$

از (1) و (2) نتیجه می گیریم که: $V_{i_{min}} = 15.32 \text{ V}$



الف) ثابت کنید مقدار \$I_2\$ ثابت است. با تغییرات ولتاژ خروجی و ولتاژ ورودی ثابت است.

ب) با فرض \$I_2\$ ثابت طرز کار مدار را تعیین کنید. ج) محدوده تغییرات \$V_o\$ را تعیین کنید.

$$2.5 < V_o < 3.0 \quad R_5 = 5.1k \quad I_{2min} = 5mA, \quad I_{2max} = 10mA$$

? < \$R_1, R_2, R_3\$?

$$I_2 = \frac{V_{R5}}{R_5} = \frac{(V_o + V_{Z1}) - (V_o + V_{BE1})}{R_5} = \frac{V_{Z1} - V_{BE1}}{R_5} = cte$$

اگر فرض کنیم که جریان شاخه های \$R_1\$ و \$R_2\$ ناچیز هستند. اگر \$V_o\$ کاهش یابد

نتیجه می گیریم که \$I_2\$ کاهش یافته است. کاهش \$V_o\$ باعث کاهش \$V_{BE1}\$ و در نتیجه

کاهش \$I_{C1}\$ می شود. چون \$I_2\$ ثابت است در نتیجه \$I_{B1}\$ افزایش می یابد. افزایش

\$I_{B1}\$ افزایش \$I_2\$ را به همراه خواهد داشت و در نتیجه \$V_o\$ افزایش می یابد.

برای تعیین محدوده \$V_o\$، پتانسیومتر را از صفر تا مقدار ماکزیمم آن تغییر می دهیم

در این صورت تغییرات ناچیزی در V_{B_r} اعمال می شود که قابل صرف نظر کردن است و

علا V_{B_r} را ثابت می گیریم. $V_{B_r} = V_{Z_r} + V_{BE_r} = 4 \text{ V}$

if $R_r \rightarrow \text{max}$: $V_A = \frac{R_r + R_w}{R_1 + R_r + R_w} V_0$

$\rightarrow V_0 = 4 \text{ V}$

if $R_r \rightarrow \text{min}$: $V_A = \frac{R_w}{R_1 + R_r + R_w} V_0 \rightarrow V_0 = 12 \text{ V}$

(2) در شرایط بحرانی باید حداقل جریان از R_4 گذشته و زنر را روشن نگه دارد :

$\rightarrow \begin{cases} I_{1 \text{ min}} = I_r + I_{Z_r \text{ min}} \end{cases}$

$\rightarrow \begin{cases} V_{R_4 \text{ min}} = V_{i \text{ min}} - (V_{0 \text{ max}} + V_{Z_r}) \end{cases}$

$I_r = \frac{V_{Z_r} - V_{BE_r}}{R_a} = 1 \text{ mA} \rightarrow I_{1 \text{ min}} = 4 \text{ mA}$

دلیل اینکه در رابطه بالا $V_{0 \text{ max}}$ قرار می دهیم این است که : برای اینکه I_1 مینیم

شود باید V_{R_4} مینیمم شود یعنی ولتاژ سردست آن ماکزیمم و ولتاژ سرچپ

$\rightarrow R_{4 \text{ max}} = \frac{V_{R_4 \text{ min}}}{I_{1 \text{ min}}} = 1,117 \text{ K}$ آن می نیمم شود.

$\begin{cases} I_{1 \text{ max}} = I_r + I_{Z_r \text{ max}} = 21 \text{ mA} \end{cases}$

$\begin{cases} V_{R_4 \text{ max}} = V_{i \text{ max}} - (V_{0 \text{ min}} + V_{Z_r}) \end{cases}$

$\rightarrow R_{4 \text{ min}} = \frac{V_{R_4 \text{ max}}}{I_{R_4 \text{ max}}} = 143 \text{ } \Omega \rightarrow 143 \text{ } \Omega < R_4 < 1117 \text{ } \Omega$

شرایط بحرانی برای R_F وقتی است که مجموع جریان R_F و I_{C2} به حد روشن

شدن زنجیر برسد. لذا اگر I_{C2} را صفر بگیریم می‌توانیم I_{R_F} بدست می‌آید:

$$\text{For } R_{F \max} : \begin{cases} V_{R_{F \min}} = V_{O \min} - V_{Z1} \\ I_{Z1 \min} = I_{C2} + I_{R_{F \min}} = 5 \text{ mA} \end{cases}$$

$$\rightarrow R_{F \max} = \frac{V_{R_{F \min}}}{I_{R_{F \min}}} = 540 \Omega$$

for $R_{F \min}$:

می‌توانیم R_F وقتی است که بیشترین جریان از زنجیر بگذرد. شرایط بحرانی وقتی است که

$$\begin{cases} V_{R_{F \max}} = V_{O \max} - V_{Z1} \\ I_{Z1 \max} = I_{C2 \max} + I_{R_{F \max}} \end{cases}$$

هم I_{C2} و هم I_{R_F} ماکزیم باشند:

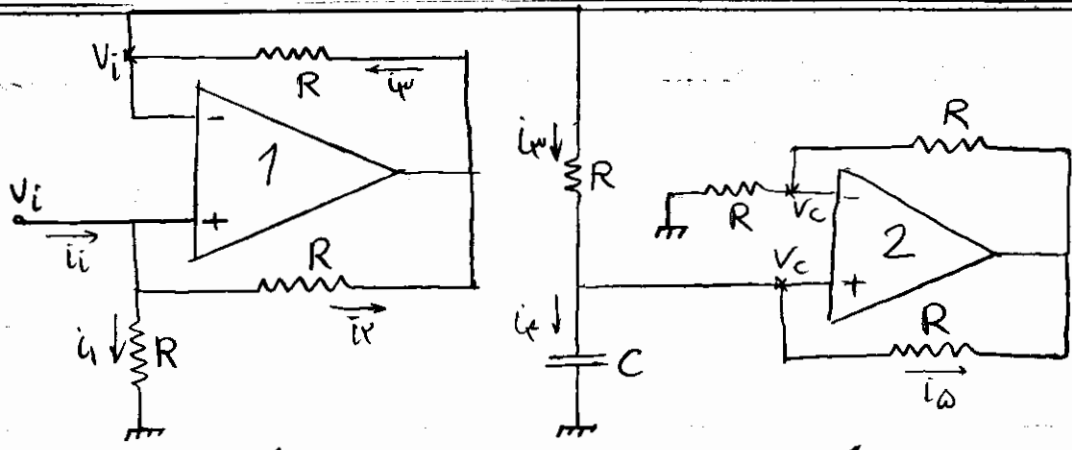
اگر β ترانزیستورها را داشتیم باید I_{R1} و I_{R_F} را جمع زده و برابر تقسیم می‌کردیم.

در این حالت I_{C2} ماکزیم بدست می‌آید. اما در اینجا با صرف نظر کردن از I_{R1} و I_{R_F}

فرض می‌کنیم ماکزیم I_{C2} با صفر شدن I_L اتفاق می‌افتد.

$$R_{F \min} = \frac{V_{R_{F \max}}}{I_{R_{F \max}}} = 451 \Omega$$

$$\rightarrow 451 \Omega \leq R_F \leq 540 \Omega$$



Zi را بدست آورده و ثابت کنید مدار به عنوان یک ژیراتور عمل می کند.

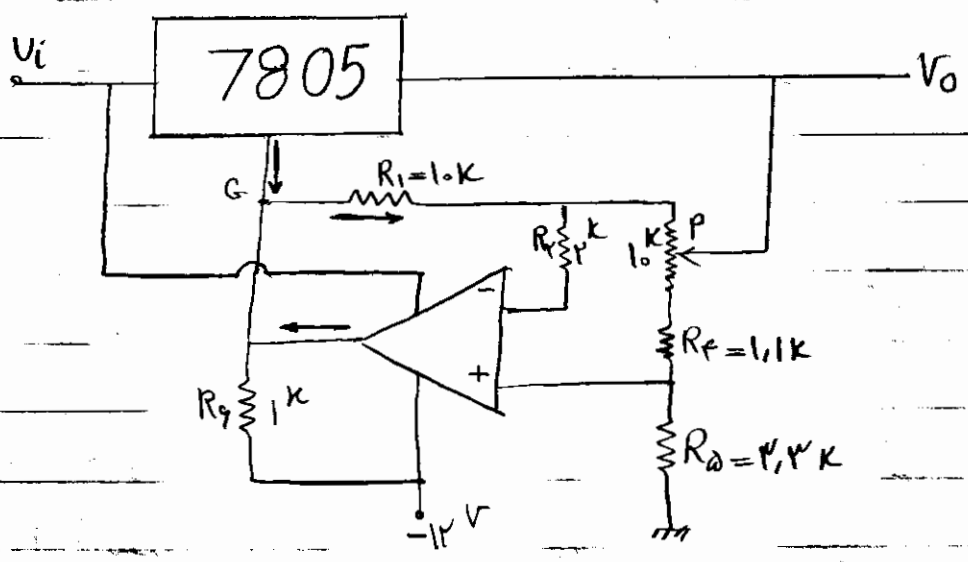
$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{I_i + I_w} \quad \text{---} \quad V_{01} = (1 + \frac{R}{R}) V_c = 2V_c$$

$$I_w = I_i + I_w \quad , \quad \frac{V_i - V_c}{R} = I_w = \frac{V_c}{RCS} + \frac{V_c - 2V_c}{R}$$

$$\rightarrow V_c = \frac{V_i}{RCS} \quad , \quad I_w = \frac{V_i - V_c}{R} = \frac{V_i - \frac{V_i}{RCS}}{R}$$

$$V_{01} = R I_w + V_i \quad , \quad I_w = \frac{V_i - V_{01}}{R} \quad , \quad I_i = \frac{V_i}{R}$$

$$\rightarrow Z_i = \frac{V_i}{I_i} = R^2 CS \quad \rightarrow L = R^2 C$$



در مدار رگولاتور شکل بالا، مینیمم و ماکزیمم V_0 را به ازاء تغییرات P بدست آورید.

(تمام المان های مدار دقتاً خطی کاری کنند)

اگر P در وضعیت مینیمم باشد:

$$V_0 = V_G + \Delta V$$

$$V_G = V_0 \left(-\frac{R_1}{P} \right) + V_+ \left(1 + \frac{R_1}{P} \right)$$

$$V_+ = V_0 \left(\frac{R_0}{R_f + R_0} \right)$$

$$V_G = V_0 - \Delta$$

$$\rightarrow V_0 = 1.0175 V$$

اگر P در وضعیت ماکزیمم باشد:

المان ها در
ناحیه خطی هستند

$$V_- = V_+$$

$$V_0 = V_0 \frac{R_0}{R_0 + R_f + P}$$

$$V_0 = 0$$

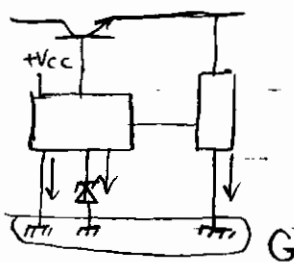
$$V_G = -\Delta V$$

$$\rightarrow 0 \ll V_0 \ll 1.0175$$

برای اینکه V_0 صفر نشود باید V_G برابر $-\Delta$ باشد. لذا وجود تغذیه منفی ضروری

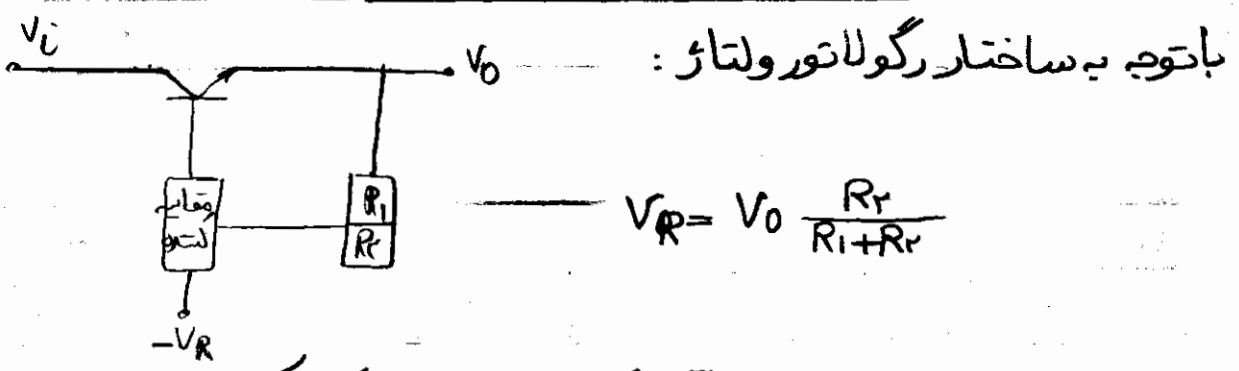
است. سوال: مقاومت R_0 چرا حتماً نیاز است؟

باتوجه به ساختمان داخلی 7805:



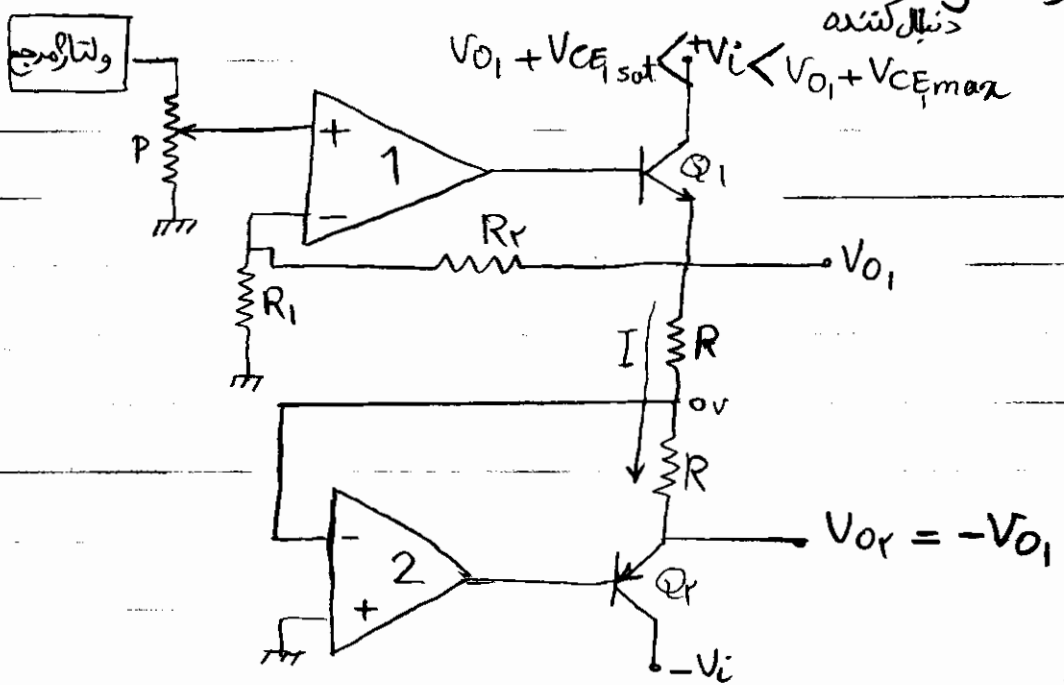
باتوجه به اینکه سه جریان همواره وارد G می شوند پس همیشه جریانی از G

رو به پاسی سرزیری شود. از طرفی یک جریان هم از خروجی Op-Amp به سمت خارج می آید. جریانی که با اینکه به سمت راست است ولی مثبت و تعیین شده است. لذا نیاز به یک مسیر جریان داریم که توسط R_f بوجود می آید. لذا برای بایاس کردن مدار ضرورت دارد.



با تغییر R_1 یا V_R می توان V_o را تنظیم کرد. در مدارهایی که تاکنون دیدیم R_1 را تغییر می دادیم حال با تغییر V_R خروجی را تنظیم می کنیم.

رگولاتور Tracking
دنبال کننده



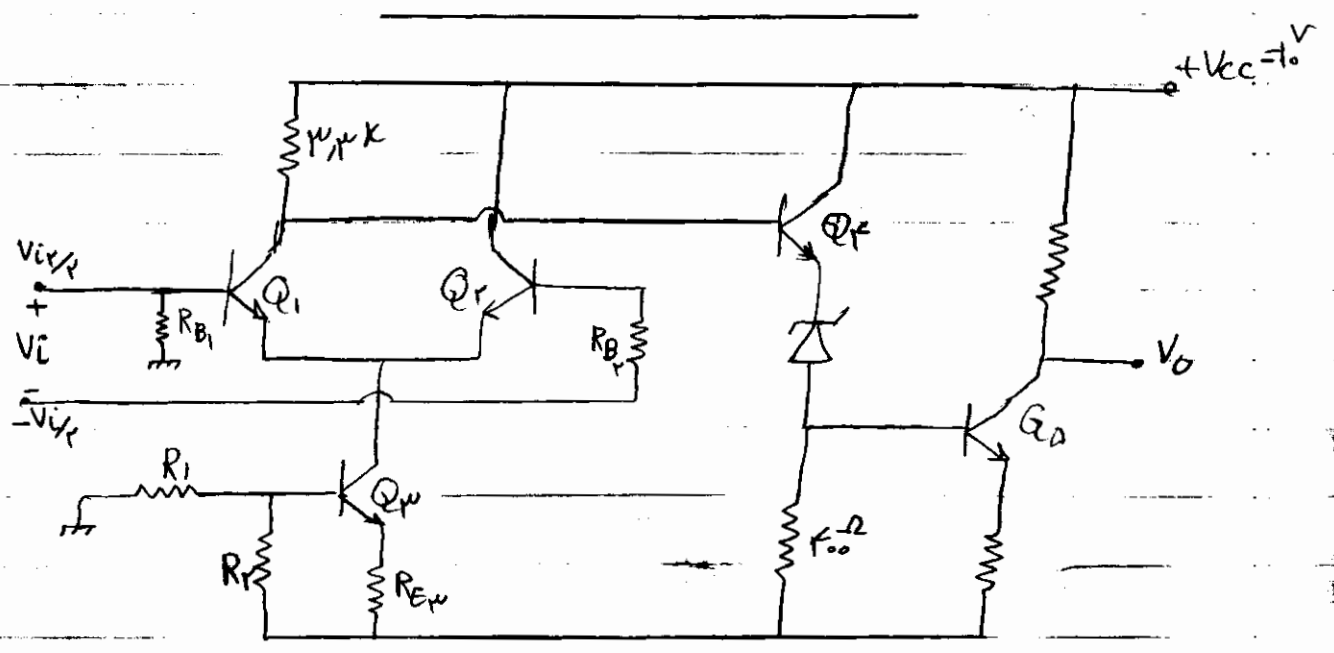
if $R_1 = R_f$, $V_R = 5V$

به این دلیل به آن دنبال کننده می گوئیم که V_{o2} دقیقاً V_{o1} را دنبال می کند. یعنی هر

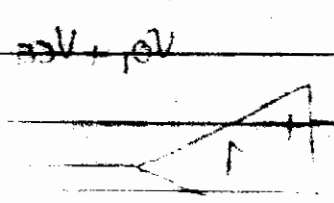
تغییری که در V_{o1} بوجود آید به همان شکل در V_{o2} بوجود خواهد آمد.

$$V_o = \frac{R_i}{R_i + R_r} \times V_o = \omega \quad \left\{ \begin{array}{l} V_i > V_{o1} \\ | -V_{i1} | > | V_{o1} | \end{array} \right.$$

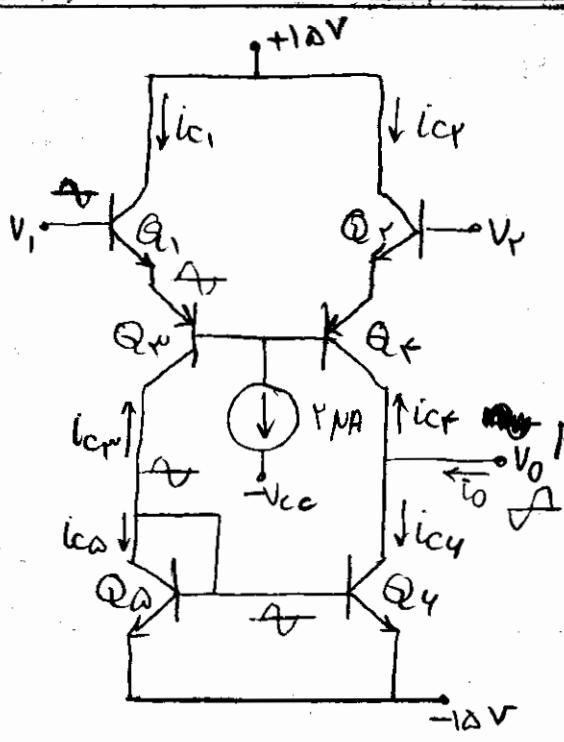
$$\rightarrow V_{o1} = 1 \cdot V = V_o$$



$$R_{id} = \frac{h_{fe} \cdot R_c}{h_{ie} + R_{B1}}$$



پایان تمام سال
: V_T



NPN : $\beta = h_{fe} = 100$
 $2V_T = 20 \text{ mV}$
 $h_{oe} = \frac{I_C}{V_{ce}}$

PNP : $h_{fe} = \beta = 100$
 $2V_T = 20 \text{ mV}$
 $h_{oe} = \frac{I_C}{V_{ce}}$

$A_d = \frac{V_o}{V_i - V_r} = ?$

if $V_i = -V_r = V$:

$\rightarrow I_{Br} = I_{Bf} = 1 \mu A \rightarrow I_{Cw} \approx I_{C1} \approx I_{C3} = 20 \mu A$

$\rightarrow h_{ie1} = \frac{2V_T \beta_1}{I_{C1}}, \quad h_{ier} = \frac{2V_T \beta_r}{I_{C_r}}$

$i_o = i_{Cf} + i_{Cy} \quad \bullet \quad i_{C1} = -i_{Cw} = i_{C3} = i_{Cy}$

$\rightarrow i_o = i_{Cf} + i_{C1} \quad ; \quad i_{Cf} = -i_{Cy}$

$\rightarrow i_o = i_{C1} - i_{Cy}$

$A_d = \frac{V_o}{V_i - V_r} = \frac{V_o}{2V} \quad \bullet \quad i_{b1} = \frac{V}{h_{ie1} + h_{ier1}}$

$\rightarrow i_{C1} = \frac{h_{fe1} \cdot V}{h_{ie1} + h_{ier}} = \frac{h_{fe1} \cdot V}{2h_{ie1}}$

$R_{ib1} = (h_{ie1} + \frac{h_{ier} \cdot \beta_1}{\beta_r}) = (h_{ie1} + \frac{2V_T \beta_r}{I_{C_r} \beta_r} \cdot \beta_1) = h_{ie1}$

$$R_{ibr} = R_{ib}, \quad \rightarrow \quad i_{br} = \frac{-v}{r_{ie1}}$$

$$\rightarrow i_{cr} = \frac{-h_{fe1} v}{r_{ie1}}$$

$$\rightarrow i_o = \frac{h_{fe1} v}{r_{ie1}} + \frac{h_{fe1} v}{r_{ie1}}$$

$$\rightarrow i_o = \frac{g_m}{r_{ie1}} v$$

$$V_o = -R_o i_o = -R_o g_m v$$

$$A_d = \frac{V_o}{v} = \frac{-R_o g_m v}{v} = \frac{-R_o g_m}{1}$$

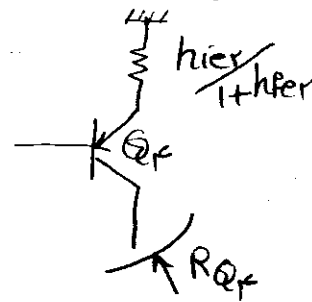
$$A_d = \frac{-R_o g_m}{1}$$

با تست کردن فاز سیگنالها (یا توجه به شکل) به درستی علامت منفی در A_d پی بریم

$$R_o = R_{Q1} \parallel R_{Q2}$$

با فرستادن سیگنال صفر:

$$R_{Q1} = \frac{1}{\frac{1}{r_{oe1}} + \left[\frac{h_{ie1} \cdot \frac{h_{ie2}}{1+h_{fe2}}}{h_{ie1} + \frac{h_{ie2}}{1+h_{fe2}}} \right]}$$



$$R_{Q2} = \frac{1}{r_{oe2}}$$